

	<h2 style="color: #C00000;">FDFMA3N109</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDFMA3N109
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2
	Datenblätter:  FDFMA3N109.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 89950 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDFMA3N109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	89950 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (2x2)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	123 mOhm @ 2.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Andere Namen	FDFMA3N109CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 2.9A (Tc) 1.5W (Ta) Surface Mount 6-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Tc)

FDFMA3N109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFMA3N109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFMA3N109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDFMA3N109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FDFMA3P029Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P CH 30V 3.3A MICRO 2X2</p>	 <p>FDFME2P823ZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.6A 6MICROFET</p>	 <p>FDFMA3W109 FAIRCHILD FDFMA3W109 FAIRCHILD</p>	 <p>FDFMA3N109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.9A MICRO2X2</p>
 <p>FDFMA2P859T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET</p>	 <p>FDFMA2P857 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET2X2</p>	 <p>FDFMA2P857 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A MICROFET2X2</p>	 <p>FDFMA2P853T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A 6-MICROFET</p>

FDFMA3N109 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDFMA3N109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDFMA3N109 Datenblatt	FDFMA3N109-Datenblätter	FDFMA3N109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFMA3N109
FDFMA3N109 Electronic	FDFMA3N109-Komponenten	FDFMA3N109-Verteiler	FDFMA3N109-Bild	FDFMA3N109-Teil
FDFMA3N109 Preis	FDFMA3N109 Hersteller	FDFMA3N109 Bild	FDFMA3N109 Aktie	FDFMA3N109 Inventar
FDFMA3N109 Neu	FDFMA3N109 Original	FDFMA3N109 garantiert	FDFMA3N109 RFQ	FDFMA3N109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited